

УСПЕХИ ФИЗИЧЕСКИХ НАУКСОВЕЩАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

538.945(048)

**НАУЧНАЯ СЕССИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ
АКАДЕМИИ НАУК СССР****(21 сентября 1988 г.)**

21 сентября 1988 г. в Институте физических проблем им. С. И. Вавилова АН СССР состоялась научная сессия Отделения общей физики и астрономии АН СССР. На сессии были заслушаны доклады:

1. Л. П. Горьков. Дальнейшие исследования в области ВТСП (обзор).

2. Л. Н. Булаевский, В. Л. Гинзбург, А. А. Собянин, А. А. Стратонников. Макроскопическая теория бездефектных и дефектных сверхпроводников с малой длиной когерентности.

Краткое содержание одного доклада приводится ниже.

538.945(048)

Л. Н. Булаевский, В. Л. Гинзбург, А. А. Собянин и А. А. Стратонников. Макроскопическая теория бездефектных и дефектных сверхпроводников с малой длиной когерентности. У известных до 1986 г. «обычных» сверхпроводников с критической температурой $T_c < 25$ К экстраполированная к нулю температуры длина когерентности $\xi(0) \equiv \xi_0$ значительно превосходит характерное межатомное или межэлектронное расстояние $d \sim 10^{-8} - 10^{-7}$ см. Поэтому критическая область вблизи T_c , в которой значительны флуктуации, оказывается малой. По последней причине обычно практически везде вблизи T_c применима теория среднего поля и, конкретно, макроскопическая Гинзбурга — Ландау (ГЛ), или Ψ -теория сверхпроводимости¹. Напротив, у обнаруженных в 1986 г. высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП), по имеющимся данным, длина ξ_0 невелика, так что отношение ξ_0/d не может, вообще говоря, считаться большим. В этой связи совершенно независимо от основной в настоящее время проблемы теории — выяснения природы и механизма ВТСП, актуальна задача создания макроскопической теории сверхпроводимости, учитывающей флуктуационные эффекты, и пригодной, в частности, в критической области.

Малость длины ξ_0 влечет за собой и еще одну важную особенность ВТСП, а именно: аномально сильное влияние на их физические свойства различных границ (в том числе границы металл — вакуум) и дефектности образца, выражающейся в присутствии в нем двойников, зерен, дислокаций и даже отдельных «точечных» дефектов (примеси, междоузельные атомы и т. п.). Разумеется, дефекты оказывают влияние и на свойства «обычных» сверхпроводников, но там это влияние проявляется, как правило, усредненно (поскольку обычно расстояние между дефектами $L \ll \xi_0$) либо очень близко к T_c (например, для границы с вакуумом при $|t| = |T - T_c| \lesssim (d/\xi_0)^2$;

см.²). Напротив, в ВТСП условия $L \ll \xi_0$ и $(d/\xi_0)^2 \ll 1$ во многих случаях нарушаются, что не дает возможности пренебрегать влиянием границ и дефектов или учитывать их усредненно.

Наконец, почти все известные нам ВТСП отличает весьма сильная анизотропия критических магнитных полей и других параметров. Это обстоятельство, конечно, также нужно учитывать при построении макроскопической теории.

Ниже мы сможем остановиться лишь на некоторых основных вопросах, а подробно соответствующие проблемы рассматриваются в статьях^{3,4}.

Основы теории. В теории^{1,5} параметр порядка представляет собой скалярную функцию $\Psi = \eta e^{i\varphi}$ (в таких случаях говорят об S-спаривании, а параметр порядка называют двухкомпонентным). В принципе, не исключено существование ВТСП с более сложными параметрами порядка^{6,7}. Обобщение теории на такие случаи актуально, но здесь ограничимся рассмотрением лишь S-спаривания. Таким образом, в основу будет положено выражение для свободной энергии⁵

$$F = F_n + \int \left[\frac{\mathbf{B}^2}{8\pi} + a|\Psi|^2 + \frac{b}{2}|\Psi|^4 + \frac{1}{4m_l^*} \left| \left(-i\hbar\nabla_l - \frac{2e}{c} \mathbf{A}_l \right) \Psi \right|^2 \right] dV; \quad (1)$$

здесь $\mathbf{B} = \text{rot } \mathbf{A}$ — вектор магнитной индукции, F_n — свободная энергия нормального состояния, $a = \alpha t$, $t = (T - T_c)/T_c$ — относительное расстояние до T_c , $2m_l^* = \{2m_x^*, 2m_y^*, 2m_z^*\}$ — главные значения тензора эффективных масс сверхпроводящих пар электронов (с зарядом $2e$). Очевидно, при $m_x^* = m_y^* = m_z^*$ мы имеем дело с Ψ -теорией изотропных сверхпроводников¹. Далее, в (1) α и b — некоторые положительные постоянные, \hbar — постоянная Планка и c — скорость света. Наконец, в (1) и ниже координатные оси предполагаются направленными вдоль главных осей симметрии кристалла, а по повторяющемуся индексу $l = \{x, y, z\}$ нужно произвести суммирование.

Равновесное (наиболее вероятное) значение $\Psi = \Psi_e$ отвечает минимуму F и находится из решения уравнений

$$\frac{1}{4m_l^*} \left(-i\hbar\nabla_l - \frac{2e}{c} \mathbf{A}_l \right)^2 \Psi + a\Psi + b|\Psi|^2\Psi = 0, \quad (2)$$

$$\text{rot } \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}, \quad (3)$$

$$j_l = -\frac{ie\hbar}{2m_l^*} (\Psi^* \nabla_l \Psi - \Psi \nabla_l \Psi^*) - \frac{2e^2}{m_l^* c} |\Psi|^2 \mathbf{A}_l; \quad (4)$$

здесь \mathbf{j} — плотность сверхпроводящего тока (плотность нормального тока считаем равной нулю).

Граничные условия к уравнениям (2) — (4) сводятся к условию непрерывности всех компонент вектора индукции \mathbf{B} на границе сверхпроводника и некоторому граничному условию на функцию Ψ . В качестве последнего на границе сверхпроводник-вакуум (диэлектрик) используется обычно условие (поле \mathbf{B} для простоты ниже полагаем равным нулю)

$$\frac{d\Psi}{dn} \Big|_s = 0, \quad (5)$$

а на границе сверхпроводник-нормальный металл — более общее условие

$$n_l \Lambda_l \frac{\partial \Psi}{\partial x_l} \Big|_s = \Psi_s, \quad (6)$$

где n_l — компоненты единичного вектора нормали к границе сверхпроводника, а Λ_l — параметры размерности длины, называемые часто длинами экстраполяции.

В ВТСП условие типа (6) необходимо, по-видимому, использовать и на границе с вакуумом, а также на границах ядер любых плоских, линейных и точечных дефектов подобно тому, как это делают для сверхтекучего⁸

и других фазовых переходов второго рода^{9,10}, где, вообще говоря, отношение $\Lambda/\xi_0 \sim \xi_0/d \sim 1$.

Обобщение на случай предельно сильной анизотропии. Для очень сильно анизотропных (слоистых) сверхпроводников приближение сплошной среды в направлении z , перпендикулярном слоям, неприменимо, и тогда вместо функционала (1) используют дифференциально-разностный функционал^{11,12}

$$F = F_n + \sum_{j=1}^N \left\{ \int \left[\frac{\mathbf{B}^2}{8\pi} + a |\Psi_j|^2 + \frac{b}{2} |\Psi_j|^4 + \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{1}{4m_l^*} \left| \left(-i\hbar \nabla_l - \frac{2e}{c} A_l \right) \Psi_j \right|^2 + r\alpha (|\Psi_j - \Psi_{j-1}|^2 + |\Psi_{j+1} - \Psi_j|^2) \right] d\mathbf{p} \right\}. \quad (7)$$

Здесь радиус-вектор \mathbf{p} лежит в плоскости слоев (x, y) , j — номер слоя, $l = \{x, y\}$, а безразмерная положительная константа r характеризует «силу» джозефсоновского взаимодействия между значениями параметра порядка $\Psi_j(\mathbf{p})$ в соседних слоях.

При $r \gg |t|$ функционал (7) переходит в трехмерный анизотропный функционал (1), а предел $r \rightarrow 0$ отвечает чисто двумерной сверхпроводимости. В ВТСП иттриевого и лантанового ряда экспериментальное значение $r \sim 1$, так что вблизи T_c их можно считать обычными трехмерными сверхпроводниками.

Учет тепловых флуктуаций. Строгий метод изучения тепловых флуктуаций, лежащий в основе современной флуктуационной теории фазовых переходов второго рода, состоит в использовании функционала (1) или (7) в качестве эффективного гамильтониана, определяющего вероятность¹³

$$w \propto \exp \left\{ -\frac{1}{k_B T} (F[\Psi(\mathbf{r})] - F[\Psi_e(\mathbf{r})]) \right\} \quad (8)$$

найти систему в состоянии с заданной функцией $\Psi(\mathbf{r})$, отличной от равновесной (наиболее вероятной) функции $\Psi_e(\mathbf{r})$.

При приближенном подходе, хорошо оправдывающем себя вблизи точки сверткекучеого λ -перехода в ^4He (см. ¹⁴), флуктуационные эффекты можно в значительной мере учесть, видоизменяя в функционале (1) температурную зависимость коэффициентов. При этом в области малых (гауссовских) флуктуаций^{13,15}

$$a \rightarrow \alpha t \left[1 + \frac{3}{4} \left(\frac{t_G}{|t|} \right)^{1/2} \right], \\ b \rightarrow b_0 \left[1 - \frac{9}{4} \left(\frac{t_G}{|t|} \right)^{1/2} \right], \\ \frac{1}{m_l^*} \rightarrow \frac{1}{m_{l,0}^*} \left[1 + \frac{3}{16} \left(\frac{t_G}{|t|} \right)^{1/2} \right], \quad (9)$$

а в области больших (критических) флуктуаций^{3,14}

$$a \rightarrow \alpha t \left(\frac{|t|}{t_G} \right)^{1/3}, \quad b \rightarrow b_0 \left(\frac{|t|}{t_G} \right)^{2/3}, \quad \frac{1}{m_l^*} \approx \text{const}. \quad (10)$$

Кроме того, поскольку в критической области коэффициенты a и b обращаются в нуль при $t \rightarrow 0$, то в (1) нужно добавить член $(1/3) g |\Psi|^6$ с положительным постоянным коэффициентом g .

В выражениях (9) величина t_G определяет ширину области больших флуктуации и связана со скачком теплоемкости ΔC_p при $T = T_c$ и средней длиной когерентности $\bar{\xi}_0 = (\xi_{0x}\xi_{0y}\xi_{0z})^{1/3}$ соотношением³

$$t_G = \frac{1}{32\pi^2} \left(\frac{k_B}{\Delta C_p \bar{\xi}_0^3} \right)^2. \quad (11)$$

Величину t_G можно также определить непосредственно из измерений амплитуды C_0^\pm первой (гауссовской) флуктуационной поправки $C_1 = C_0^\pm / |t|^{1/2}$ к теплоемкости при $t > 0$ или $t < 0$:

$$t_G = \left(\frac{C_0^-}{\Delta C_p} \right)^2 = 2 \left(\frac{C_0^+}{\Delta C_p} \right)^2. \quad (12)$$

В частности, из данных¹⁶ следует, что в монокристаллах $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ параметр $t_G \sim 10^{-3}$, т. е. ширина критической области здесь лишь порядка 0,1 К. Тем не менее вклад флуктуационных эффектов в C_p вполне заметен и достигает 10% от ΔC_p при $|T - T_c| \sim 10$ К, а при $|T - T_c| \sim 1$ К он составляет уже ~30%.

Наиболее яркий вывод флуктуационной теории состоит в том, что внутри флуктуационной области отношение κ глубины проникновения магнитного поля δ к длине когерентности ξ должно уменьшаться при $T \rightarrow T_c$ и, таким образом, в достаточной близости к T_c сверхпроводник второго рода должен превращаться в сверхпроводник первого рода. К сожалению, в известных ВТСП исходное значение κ вдали от T_c велико, и этот эффект вряд ли можно наблюдать экспериментально.

Влияние границ и дефектов. В граничном условии (6), остающемся справедливым и в критической области, знак параметра Λ заранее не определен и может быть, в принципе, как положительным, так и отрицательным. Особенно интересен последний случай, так как тогда сверхпроводимость появляется первоначально при некоторой температуре $T'_c > T_c$ в узком слое вблизи границы (или в малой области вблизи ядра дефекта) с характерной толщиной $\xi(t'_c) = \xi_{0x} |t'_c|^{-1/2}$, где $t'_c = (T'_c - T_c) \times (T_c)^{-1}$. При понижении температуры этот слой расширяется, а при $T < T_c$ сверхпроводимость распространяется на весь кристалл.

Явление такой «локальной» сверхпроводимости наблюдалось вблизи границ двойников во многих «обычных» сверхпроводниках¹⁷. Вполне вероятно поэтому, что оно должно иметь место и в ВТСП, где плоскости двойникования (ПД) присутствуют, как правило, в очень большом количестве. В пользу последнего предположения говорит большое число экспериментальных фактов¹⁸⁻²⁰ и особенно данные^{16,21} измерений теплоемкости в «монокристаллах» $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$, детально анализировавшие в работе⁴. На рис. 1 и 2 дано сравнение результатов расчетов⁴ (основанных на выражениях (1) — (6) и учитывавших гауссовские флуктуационные эффекты) с экспериментальными данными^{16,21} в нулевом внешнем магнитном поле и в поле с напряженностью 30 кЭ.

Хорошее совпадение экспериментальных и расчетных кривых подтверждает правильность исходного предположения о некотором усилении сверхпроводимости вблизи ПД. Кроме того, из сравнения с данными^{16,21} можно рассчитать значения всех фигурирующих в (1) параметров сверхпроводника, а также оценить величину параметра Λ и среднее расстояние между двойниками L . Значения этих величин таковы (m_e — масса свободного электрона): $\Lambda \approx -75 \text{ \AA}$, $L \approx 1500 \text{ \AA}$, $\bar{\xi}_0 = 8 \pm 0,5 \text{ \AA}$, $\xi_{0x} \approx \xi_{0y} = 15 \pm 3 \text{ \AA}$, $\xi_{0z} \approx 2 \pm 0,5 \text{ \AA}$, $\alpha = 1,2 \cdot 10^{-14} \text{ эрг}$, $b = 4,0 \cdot 10^{-36} \text{ эрг} \cdot \text{см}^3$, $m_x \approx m_y \approx (10 - 14) m_e$, $m_z \approx (250 - 1500) m_e$.

При получении четырех последних значений мы пренебрегли возможной слабой анизотропией эффективных масс в плоскости слоев $\text{Cu} - \text{O}$ и норми-

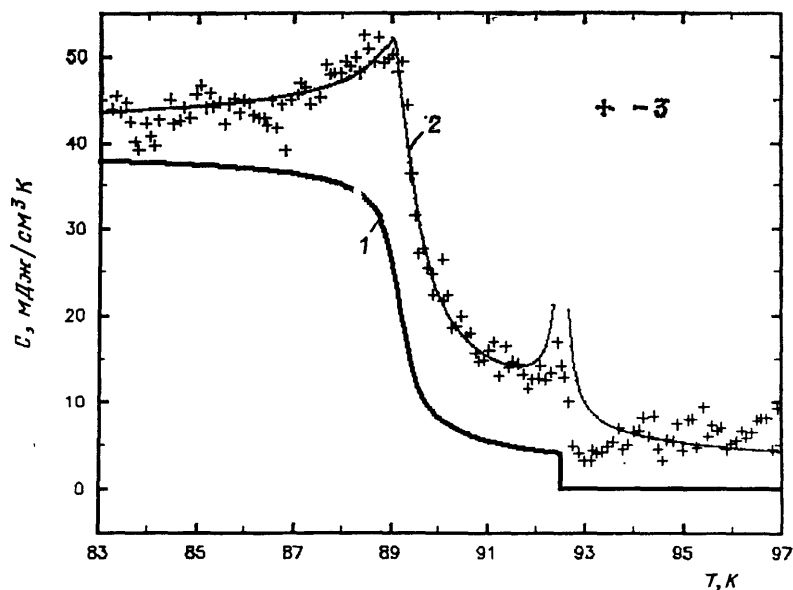


Рис. 1. Температурная зависимость сверхпроводящего вклада в теплоемкость для одного из исследованных в ¹⁶ («аргошнского») кристалла $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ в нулевом внешнем магнитном поле. 1 — результаты теоретических вычислений * без учета флуктуационных эффектов при следующих значениях параметров: $\Delta C_p = 14 \text{ мДж/см}^3\text{К}$, $L/\xi_{0x} = 100$, $\Lambda/\xi_{0x} = -5$; 2 — то же при учете тепловых флуктуаций и $\xi_0 = 9 \text{ Å}$; 3 — экспериментальные данные ¹⁶

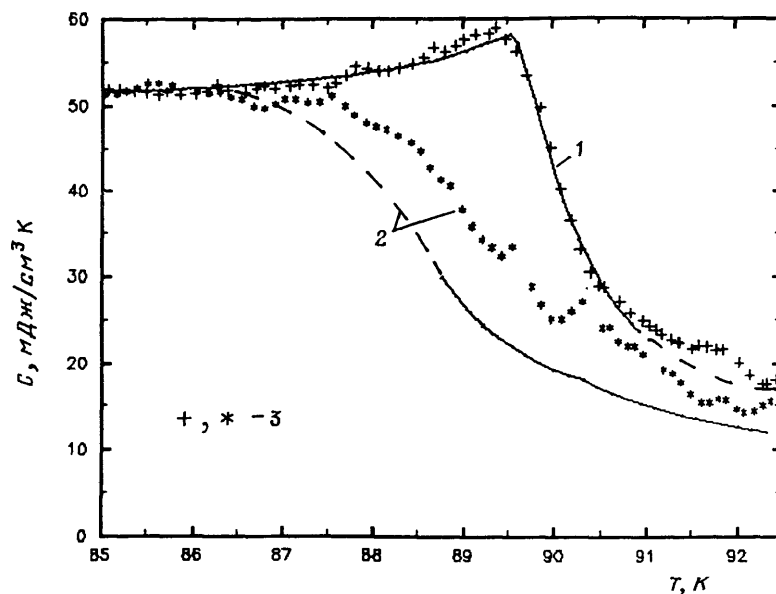


Рис. 2. Температурная зависимость сверхпроводящего вклада в теплоемкость для «илинойского» кристалла. 1 — в поле $H = 0$, 2 — в поле $H = 30 \text{ кГ}$. Сплошные кривые — результаты теоретических вычислений * при $\Delta C_p = 42 \text{ мДж/см}^3\text{К}$, $\xi_0 = 8 \text{ Å}$, $L/\xi_{0x} = 87$, $\xi_{0x}/\xi_{0z} = 8$, $\Lambda/\xi_{0x} = -5$. Штриховые кривые — экстраполяция расчетных кривых в те области температур, где строгий расчет затруднен. 3 — экспериментальные данные ^{16,21}

ровали параметр порядка на концентрацию сверхпроводящих пар при нулевой температуре $n_s(0) = \alpha/b = 3 \cdot 10^{21} \text{ см}^{-3}$, что соответствует приблизительно половине пары на элементарную ячейку. Отметим, что такой выбор

нормировки Ψ , конечно, условен и не сказывается ни на каких физических результатах теории.

В ы в о д ы . Выше мы рассмотрели некоторые особенности макроскопической теории ВТСП и продемонстрировали ее эффективность на примере интерпретации экспериментальных данных о критической аномалии теплоемкости в кристаллах $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$. Макроскопическая теория не чувствительна к конкретным микроскопическим механизмам сверхпроводимости, и в этом плане она проще и надежнее, чем микроскопическая теория. Вместе с тем, и в области макроскопической теории ВТСП имеется еще ряд нерешенных вопросов. Один из таких вопросов связан с возможной реализацией в некоторых ВТСП более сложных типов сверхпроводящих фаз, описываемых векторным или тензорным параметром порядка и напоминающих сверхтекучие фазы ^3He . Описание^{6,7} таких фаз было бы в ряде отношений иным, чем рассмотренное выше макроскопическое описание «скалярной» сверхпроводимости.

Второй очень важный вопрос касается отмеченной недавно в²² возможной неприменимости в случае сверхпроводников с очень сильным запаздывающим электрон-фононным взаимодействием классических методов учета флуктуации, базирующихся на формуле (8) и хорошо зарекомендовавших себя для всех других фазовых переходов второго рода.

Выяснение этих вопросов и, главное, проверка различных выводов макротории представляют большой интерес и требуют дальнейших экспериментальных и теоретических исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- ¹ Гинзбург В. Л., Ландау Л. Д.//ЖЭТФ. 1950. Т. 20. С. 1064.
- ² Де Жен П. Сверхпроводимость металлов и сплавов.—М.: Мир, 1968.
- ³ Булаевский Л. Н., Гинзбург В. Л., Собянин А. А.//ЖЭТФ. 1988. Т. 94. С. 355; Physica. Ser. C. 1988. V. 152. P. 378.
- ⁴ Sobyanin A. A., Stratonnikov A. A.//Ibidem. V. 153—155. P. 1681; ЖЭТФ. 1989, т. 95.
- ⁵ Гинзбург В. Л.//ЖЭТФ. 1952. Т. 23. С. 236.
- ⁶ Воловик Г. Е., Горьков Л. П.//ЖЭТФ. 1985. Т. 88. С. 1412.
- ⁷ Марченко В. И.//ЖЭТФ. 1987. Т. 93. С. 583.
- ⁸ Собянин А. А.//ЖЭТФ. 1971. Т. 61. С. 433.
- ⁹ Каганов М. И., Омельяничук А. Н.//Ibidem. С. 1679.
- ¹⁰ Собянин А. А., Стратонников А. А. ЖЭТФ. 1984. Т. 87. С. 1442.
- ¹¹ Lawrence W. E., Doniach S.//Proc. of 12th Conference on Low Temperature Physics (LT-12).—Kyoto, Japan, 1970.—P. 361.
- ¹² Булаевский Л. Н.//УФН. 1975. Т. 116. С. 449.
- ¹³ Гинзбург В. Л.//ФТТ. 1960. Т. 2. С. 2031.
- ¹⁴ Гинзбург В. Л., Собянин А. А.//УФН. 1976. Т. 120. С. 153; 1988. Т. 154. С. 545.
- ¹⁵ Вакс В. Г., Ларкин А. И., Пикин С. А.//ЖЭТФ. 1966. Т. 51. С. 361.
- ¹⁶ Inderhees S. E., Salamon M. B., Goldenfeld N., Rice J. P., Pazo l P. G., Ginsberg D. M., Lin J. Z., Crabtree G. W.//Phys. Rev. Lett. 1988. V. 60. P. 1178.
- ¹⁷ Хлюстиков И. Н., Буздин А. И.//УФН. 1988. Т. 155. С. 47.
- ¹⁸ Fang M. M., Kogan V. G., Finnemore D. K., Clem J. R., Chamberley L. S., Farrell D. E.//Phys. Rev. Ser. B. 1988. V. 37. P. 2334.
- ¹⁹ Athreya K., Hyun O. B., Ostenson J. E., Clem J. R., Finnemore D. K. Preprint IS-J 3008.—Iowa State Univ., 1988.
- ²⁰ Vieira S., Zhou P., Solin S. A., Garcia N., Hortal M., Aguilo A. Preprint.—Michigan State Univ., 1988.
- ²¹ Ginsberg D. M., Inderhees S. E., Salamon M. B., Goldenfeld N., Rice J. P., Pazo l B. G.//Physica Ser. C. 1988. V. 153—155. P. 1082.
- ²² Bulaevskii L. N., Dolgov O. V.//Sol. State Commun. 1988. V. 67. P. 63.